

# ВПЛИВ ВІДХИЛУ ВІД СТЕХІОМЕТРІЇ НА ТЕМПЕРАТУРНІ ЗАЛЕЖНОСТІ КІНЕТИЧНОИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛІКРИСТАЛІВ $\text{Bi}_2\text{Te}_3$

Будник О.В., Рогачова О.І., Тищук М.Ю.

*Національний технічний університет  
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків*

В наш час напівпровідникова сполука  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$  та тверді розчини на її основі відносяться до числа найкращих низькотемпературних термоелектричних матеріалів, що мають широке застосування в промисловості [1, 2]. Проте, незважаючи на велику кількість робіт, присвячених дослідженню властивостей телуриду вісмута [2], у більшості з них досліджувались лише зразки стехіометричного складу. Тому вплив відхилення від стехіометрії на температурні залежності властивостей  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$  потребує окремого ретельного дослідження.

Мета роботи - визначення впливу відхилення від стехіометрії на температурні залежності кінетичних властивостей полікристалів  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$ .

Об'єкт дослідження - полікристалічні зразки  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$  з різним вмістом телуру (59,6 – 60,2 та 62,8 ат. % Te).

Встановлено, що хід температурних залежностей для електропровідності та рухливості носіїв заряду як для полікристалічних, так і для монокристалічних зразків має однаковий характер, обумовлений сильним виродженням напівпровідникової сполуки  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$ . Виявлено, що відхилення від стехіометрії призводить до зниження абсолютних значень електропровідності та рухливості основних носіїв заряду, а також зумовлює більш похилий хід їх температурних залежностей. Такі процеси можна пояснити збільшенням внеску розсіювання основних носіїв заряду на антиструктурних дефектах, концентрація яких суттєво зростає з відхиленням від стехіометрії та не залежить від температури.

Одержані результати представляють практичний інтерес для промисловості при проектуванні термоелектричних приладів на основі полікристалічного  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$ .

1. Scherrer H. Bismuth Telluride, Antimony Telluride and their Solid Solution / H. Scherrer, S. Scherrer // CRC Handbook of thermoelectric Edited by D.M. Rowe. – 1995. – P. 213–223.
2. Гольцман Б.М. Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе  $\text{Bi}_2\text{Te}_3$  / Гольцман Б.М., Кудинов В.А., Смирнов И.А. –М.: Наука, 1972. – С. 306.